	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 S1XS216DE (单胞)	文件编号	临时
	肖特基二极管	版本号	18-A1-11
		页码	1/2

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

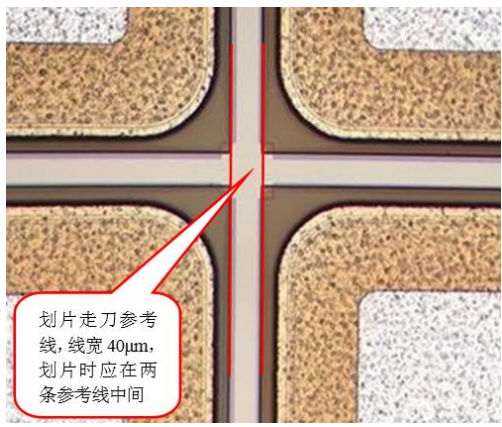
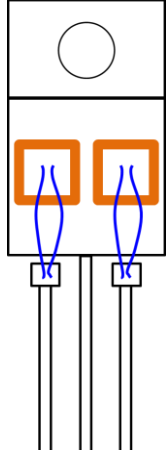
用 S1XS216DE 封装的成品管用于开关电源、高频逆变器、极性保护电路等各类电子电路上。

1.2 主要特点

- 高 ESD 能力
- 低功耗
- 高抗浪涌电流能力

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸		3.5 mm×3.5mm
			137.79 mil×137.79 mil
	芯片厚度 (μm) (推荐)		260 ± 20
	▷划片道尺寸 (μm)		40
	键合区面积 (μm ²)	正面	2500×2500
	正面电极 (阳极)	金属	铝
		厚度 (μm)	9.0 ± 1.5
	背面电极 (阴极) (推荐)	表层金属	银
	硅片直径 (mm)		Φ150
	装片要求 (推荐)		焊料
	★键合要求 (推荐)		2 根 Φ500μm 铝线 (单胞)

 <p>划片走刀参考线, 线宽 40μm. 划片时应在两条参考线中间</p>	
▷划片道示意图	★封装示意图 (推荐)


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 S1XS216DE (单胞)	文件编号	临时
	肖特基二极管	版本号	18-A1-11
		页码	2/2

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	45	V	推荐封装形式: T0-3P 推荐成品型号: MBR3045 MBR6045PT
正向电流	$I_{F(AV)}$	30 (单胞)	A	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_R	$I_R=100\mu\text{A}$	45	—	—	V
反向电流	I_R	$V_R=45\text{V}$	—	25	50	μA
正向电压	V_F	$I_F=30\text{A}$	—	0.58	0.61	V

3.3 典型特性曲线

暂无

注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532